

Экз. рабочий электронный

УТВЕРЖДАЮ

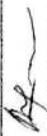
Генеральный директор
ЗАО «Светлана-Рост»


В.П. Чалый
«12» _____ 2016 г.


QWIP-МАТРИЦА

Технические условия
СВБШ.432234.003 ТУ
(введены впервые)

Срок действия: до 01.2022 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
0175		30.017		

Перв. Поимен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на полупроводниковую QWIP-матрицу фоточувствительных элементов (далее по тексту – кристалл QWIP-матрицы).

По настоящему ТУ выпускаются кристаллы QWIP-матрицы на диапазон длин волн от 8 до 9 мкм.

Кристаллы QWIP-матрицы предназначены для изготовления охлаждаемых многоэлементных фотоэлектрических полупроводниковых приемников излучения или фотоприемных модулей на диапазон длин волн от 8 до 9 мкм.

Настоящие ТУ являются обязательным руководством при изготовлении, приемке и поставке.

Условное обозначение кристалла QWIP-матрицы состоит из следующих элементов: наименования, формата матрицы, шага фоточувствительных элементов (в мкм) и области спектральной чувствительности (в мкм).

Пример записи при заказе и в конструкторской документации другого изделия:

Кристалл QWIP-матрицы (640x512)-20-(8-9) СВБШ.432234.003 ТУ.

Нормативные ссылки приведены в приложении А.

Термины, применяемые в настоящем ТУ, и их определения приведены в приложении Б.

СВБШ.432234.003 ТУ

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Азетова	<i>Аз</i>	26.12.16
М.эксп.		Прокофьев	<i>П</i>	26.12.16
Согл.		Кацавец	<i>К</i>	26.12.16
Н.контр.		Кушнаренко	<i>К</i>	26.12.16
Согл.		Красовицкий	<i>К</i>	26.12.16

QWIP-матрица
Технические условия

Лит.	Лист	Листов
	2	19

Подп. и дата
К 30.01.17

Инв. № подл.
0175

Соответствие фотоэлектрических параметров кристалла QWIP-матрицы требованиям таблицы 2 гарантируется технологией изготовления¹. Методы контроля – по ГОСТ 17772.

1.1.4 Массогабаритные параметры кристалла QWIP-матрицы в зависимости от формата приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Массогабаритные параметры

Параметр	Формат		
	640×512	384×288 (шаг 20 мкм)	384×288 (шаг 25 мкм)
длина, мм	11,2 ± 0,1	6,8 ± 0,1	8,3 ± 0,1
ширина, мм	13,7 ± 0,1	8,5 ± 0,1	10,5 ± 0,1
толщина, мм	0,65 ± 0,05	0,65 ± 0,05	0,65 ± 0,05
масса, г, не более	1,0	0,40	0,60

Соответствие габаритных размеров предъявляемым требованиям обеспечивается технологией изготовления.

1.1.5 Требования по сохраняемости

Срок хранения кристаллов QWIP-матрицы с даты поставки до их герметизации в составе фотоприемных устройств – 12 месяцев.

На протяжении этого срока допускается:

а) хранение кристаллов QWIP-матрицы у потребителя в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или в хранилище с кондиционированным воздухом в течение 12 месяцев;

б) нахождение кристаллов QWIP-матрицы после их изъятия потребителем из упаковки изготовителя в помещении с классом чистоты не ниже 7 ИСО по классификации ГОСТ ИСО 14644-1 в течение срока до 3 месяцев.

¹ Контроль фотоэлектрических параметров проводится на тестовых фотоприемниках, изготавливаемых в одном технологическом процессе с QWIP-матрицами

Инд. № годп.	0175
Подп. и дата	И. 30.01.17
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СВБШ.432234.003 ТУ